CLIPPEDIMAGE= JP359026277A

PAT-NO: JP359026277A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59026277 A TITLE: PRODUCTION OF THERMAL HEAD

PUEN-DATE: February 10, 1984

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
TAKAMATSU, YASUHIKO
SUGANO, OSAMU
YAMAGUCHI, TAKAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION: NAME

RICOH CO LTD

APPL-NO: JP57135932 APPL-DATE: August 4, 1982

INT-CL (IPC): B41J003/20; H01L049/00 US-CL-CURRENT: 219/216,347/200

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent a plated metal layer from being delaminated, by a method wherein a pattern of a photoresist layer is provided in a region including an abrasion-resistant layer and excepting a bonding part of an electrode, and the electrode is plated with gold by using the photoresist pattern as a mask.

COUNTRY.

N/A

CONSTITUTION: A tantalum nitride layer 10, a nichrome layer 11, a gold layer 12 and the plated gold layer 13 are provided in four layers on a ceramic substrate 1 by appropriate means, thereafter the layers are patterned to produce a heating resistor and the electrode. Then, a silicon dioxide layer 14 as a protective layer and a tantalum pentoxide layer 15 as the abrasion-resistant layer are provided in two layers by a mask sputtering method. Subsequently, a

03/25/2002, EAST Version: 1.03.0002

photoresist is applied to the entire upper surface of the thermal head in this condition, is then exposed to light through a mask, and is developed so that the photoresist remains in the area of the pattern 20.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

002 N/A

APPLICATION-D

N/A

03/25/2002, EAST Version: 1.03.0002

(B) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—26277

(f) Int. Cl.³ B 41 J 3/20 H 01 L 49/00 識別記号 103 庁内整理番号 8004-2C 6370-5F **②公開 昭和59年(1984)2月10日**

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

64サーマルヘッドの製造方法

②特 願 昭57-135932

②出 願 昭57(1982)8月4日

@発 明 者 髙松恭彦

東京都大田区中馬込1丁目3番 6号株式会社リコー内

@発 明 者 菅野修

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

⑦発 明 者 山口隆行

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

仍代 理 人 弁理士 青山葆

外2名

明 細 書

1.発明の名称

サーマルヘットの製造方法

2.特許請求の範囲

(1) 基板上に発熱抵抗体、放発熱抵抗体の接続部上面に電極、更に上記発熱抵抗体の露出部上面及び上記電極の一部の上面に保護膜及び耐摩耗層がそれぞれパターン化されて形成された状態において、更に保護膜及び耐摩耗層を含み、少なくとも上記電極のポンデイングが行なわれる部分を除く領域にレジストパターンを形成し、該レジストパターンをマスクとして電極にメンキを施すことを、特徴とするサーマルヘットの製造方法。

3.発明の詳細な説明

本発明はサーマルヘットの製造方法に関し、特に電極構造を改良した薄膜型サーマルヘットの製造方法に関する。

サーマルヘッドには、例えば第1図に示される ように、セラミック基板1の表面にその長手方向 に沿つて形成された発熱抵抗体2に接して、その 一方の個に慰動回路に接続される駅動用電極3、他方の個に共通電極4が形成されたもの、あるいは第2図に示されるように、発熱抵抗体2の両個に駆動用電極3と共通電極4が適当な単位で交互に繰り返して配列されるように形成されたものなどがある。5は発熱抵抗体の郷出部2の全てと、駅動用電極3の一部及び共通電極4の一部を含む領域に形成された保護膜と耐摩耗層との2層構造(以下耐摩耗層等という)である。

駆動用電極3と駆動回路との接続はテープキャリア方式などの方法を用いてポンディングにより行なわれ、また共通電極4には大電流が流れる。ところで、神膜型サーマルヘッドは薄膜形成技術により製造されるので駆動用電極3や共通電極4のような電極はせいぜい1~2μmの厚さであり、あまり厚く形成することができない。そのため、駆動用電極3へのポンディングの強度が弱く、また共通電極4に十分な電流を流すことができない間関がある。

そこで本出願人はこのようなサーマルヘッドに

おいて、更に耐摩耗層等5をマスクとして、露出 している電極上にメッキにより金脂を厚く付着さ せることにより上記問題を解決する技術を開発し、 既に出願した。その方法により製造されるサーマ ルヘッドの一例の断面図は、第3図に示されるよ 5に、セラミック基板1上に発熱抵抗体となる窒 化タンタル(TazN)届10がパターン化されて おり、その上に駆動用電極3及び共通電極4のよ うた電機としてニクロム(NiCr) 層11、金 (Au)層12及び金メッキ層13がパターン化 されて形成されている。駆動用電極3及び共通電 極4で挾まれた領域が発熱に寄与する発熱抵抗体 パターン2である。この発熱抵抗体パターン2の 上部に電優3及び4の一部の上部を含んで保護膜 としての二酸化ケイ素(SiO2)層14と耐摩耗 届としての五酸化タンタル層(Ta₂O₅)15が形 成されている。そしてとれら耐摩耗層等5の外側 の電極3及び4上には金層16がメッキにより形 成されている。ノッキによる金層16は厚く形成 できるので上記の問題が解決でき、しかもとの方

しかしながら、この方法では駆動用電極3のボンディング部以外の他の広い領域にも金が付着するため金の消費量が多くなり、コストアップにつながる問題がある。また保護膜14及び耐摩耗層15はマスクスパッタリング法で形成するため通常その増部17は急峻ではなく、なだらかな勾配をもつ。そのため駆動用電極3のパターン上で耐摩耗解等5がなだらかに変化する部分、所願だれ、の部分では駆動用电極3のパターンのエッジ部に沿つてメッキがひげ状に成長し、このひげ状の金メッキ層が剥れ、電極間に付着して電後間で短絡が生じる問題もある。

法は簡便である利点も有している。

本発明は、従来のサーマルヘッドの電優上に更 にメッキにより金層を形成するに当り、上配不具 合を解消する方法を提供することを目的とするも のであつて、従来の方法により耐摩耗層まで形成 した後、耐摩耗層等5を含み、少なくとも電極の ポンデイング部を除いた領域にフォトレジスタな どのレジストの層のパターンを形成し、このレジ

ストパターンをマスクとして電徳上に金メッキを施すことにより上記目的を達成せんとするものである。

以下本発明の一実施例について説明する。

第4図(N)は耐摩耗層15まで形成した状態を示す断面図である。との状態までの製造工程としては、セラミック基板1上に窒化タンタル層10、ニクロム層11、金層12及び金メッキ層13を適当な手段で4層に形成した後、フォトリングラフィー技術によりパターン化を行なつて発熱抵抗体と電極を形成する。次に同図のような領域に保護膜としての二酸化タンタル層15とをマスクスパッタリング法により2層に形成すればよい。

次にこの状態のサーマルヘッドの上面全面にフォトレジストを塗布した後、マスクを介して露光し、現像して、第4図的に示されるように、第2図の破線で囲まれるようなパターン20にフォトレジスタを残存させる。すなわち、この状態では駆動用電極3のポンデイング部21と共通電極4

の一部がフォトレジスト20で被殺されずに露出 していることになる。また、フォトレジスト20 のパターン端部22にはだれは発生しない。

次化、同図に示されているように、このフォトレジストパターン20をマスクとして金メッキ処理を施す。メッキは電極3及び4の第出部でのみ進行する。メッキ層16の厚さは数μm以上、例えば7μm以上程度が好ましい。メッキ完了後、フォトレジスト層20を剥離液化で除去すれば、第4図(3に示されるようを共通電極4の一部と駆動用電極3のポンデイング部21の電極腹厚が厚くなつたサーマルへッドが得られる。

なお、本発明は電極の一部の膜厚を厚くする方法に特徴を有するものであるので、第4図(A)の状態までは実施例のものに限定されないことは信うまでもない。すなわち、例えば、発熱抵抗体層10としては強化タンタルの外、ニクロム、ネサ膜その他既知の適当な材料を使用してもよく、また、電優構造も例示の3層構造に限らず、最上層だけが金であれば下層に他の適当な導電材料を使用す

ることも可能である。さらに、耐摩耗層等 5 も、例示の構造以外に、炭化ケイ素(S i C)酸化アルミニウム($\Lambda \ell_2 O_2$)などを用いることも可能である。

以上のように、本発明によればレジスト層を耐磨耗層等より広い領域に形成し、そのレジスト層をををマスクとして電極の一部に金メッキが施されるので、金が付着する領域が狭くなり、したがかつきる。また、レジスト層の端部には、だれが発生としないので、仮に耐摩耗層等の端部にだれが発生としないのでもメッキがひげ状に成長するようなととしななく、したがつてそのひげ状メッキ層の剥離による電極短絡などの不良が発生することととも相切なく、したがつてそのひが状メッキ層の剥離によりなく、したがつてそのひげ状メッキ層の剥離によりでは低間の短絡の確率も減少し、製造歩留りを上げるとができる。

4.図面の簡単な説明

第1図及び第2図は本発明が適用されるサーマ

ルヘッドのパターンの例を示す平面図、第3図は 既に提案された改良されたサーマルヘッドの発熱 抵抗体近傍を示す断面図、第4図()ないし()は本 発明の工程を示す発熱抵抗体近傍の断面図である。

1…セラミック基板、2…発熱抵抗体、3,4 …電極、5…耐摩耗層等(保護膜及び耐摩耗層)、 20…レジストパターン、21…電極のポンデイ ング部、16…金メッキ層。

特許出願人 株式会社 リコー 代 理 人 弁理士 青山 葆 外2名

